

4
6 May 02
PATENT
R. Tally

Practitioner's Docket No.: 782_193

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of: Tomohiko SHIBATA, Yukinori NAKAMURA, Mitsuhiro TANAKA and Keiichiro ASAII

Ser. No.: 10/004,345

Group Art Unit: 2817

Filed: November 2, 2001

Examiner: Not Assigned

Conf. No.: 3689

For: A METHOD FOR FABRICATING A III-V NITRIDE FILM AND AN APPARATUS FOR FABRICATING THE SAME

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

I hereby certify that this correspondence is being deposited on March 28, 2002 with the United States Postal Service under "EXPRESS MAIL" mailing label no. EV 021244825 to:

Box Missing Parts
Assistant Commissioner for Patents
Washington D.C. 20231.

Desireé M. Bennett


Desireé M. Bennett

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY(IES) OF PRIORITY DOCUMENT(S)

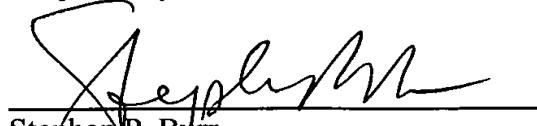
Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country was requested by applicants on November 2, 2001 for the above-identified application:

<u>Country</u>	<u>Application Number</u>	<u>Filing Date</u>
Japan	2000-347,735	November 15, 2000

In support of this claim, a certified copy of the Japanese Application is enclosed herewith.

Respectfully submitted,


Stephen P. Burr
Reg. No. 32,970

SPB/dmb

BURR & BROWN
P.O. Box 7068
Syracuse, NY 13261-7068

Customer No.: 25191
Telephone: (315) 233-8300
Facsimile: (315) 233-8320



日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2000年11月15日

出願番号
Application Number:

特願2000-347735

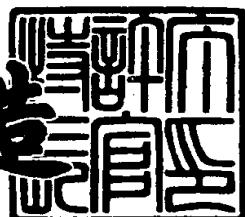
出願人
Applicant(s):

日本碍子株式会社

2001年12月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3106624

【書類名】 特許願
 【整理番号】 00P00530
 【提出日】 平成12年11月15日
 【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿
 【国際特許分類】 H01L 21/205
 【発明の名称】 I I I V族窒化物膜の製造方法および製造装置
 【請求項の数】 8
 【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式
 会社内
 【氏名】 柴田 智彦
 【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式
 会社内
 【氏名】 中村 幸則
 【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式
 会社内
 【氏名】 田中 光浩
 【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式
 会社内
 【氏名】 浅井 圭一郎
 【特許出願人】
 【識別番号】 000004064
 【氏名又は名称】 日本碍子株式会社
 【代理人】
 【識別番号】 100072051
 【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

【識別番号】 100059258

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 晓秀

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074997

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703804

【書類名】 明細書

【発明の名称】 IIIV族窒化物膜の製造方法および製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスと直接接触する内壁の、ほぼ1000°C以上の高温に加熱される部分の表面に $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングした反応管内に原料ガスをキャリアガスと共に導入し、有機金属ガスとアンモニアガスとの反応により生成される金属窒化物を、加熱されたサセプタによって支持された基板に堆積させて $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させて成膜することを特徴とするIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項2】前記基板を支持するサセプタの表面に $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングした反応管を使用することを特徴とする請求項1に記載のIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項3】前記反応管内に、トリメチルアルミニウムガスとアンモニアガスとを含む原料ガスを導入してアルミリッチな $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1, x>0.5$)膜を成膜することを特徴とする請求項1または2に記載のIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項4】前記反応管内に、トリメチルアルミニウムガスとアンモニアガスとを含む原料ガスを導入してAIN膜を成膜することを特徴とする請求項1または2に記載のIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項5】有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスと直接接触する内壁の、ほぼ1000°C以上の高温に加熱される部分の表面に、アルミリッチな $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1, a>0.5$)膜をコーティングした反応管を用いる請求項1~4の何れかに記載のIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項6】有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスと直接接触する内壁の、ほぼ1000°C以上の高温に加熱される部分の表面に、AIN膜をコーティングした反応管を用いる請求項1~4の何れかに記載のIIIV族窒化物膜の製造方法。

【請求項7】MOCVD法によって基板上に $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキ

シャル成長させる装置において、反応管と、この反応管の内部に曝されるように基板を支持するサセプタと、このサセプタを介して前記基板を加熱する加熱手段と、前記反応管内に有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスをキャリアガスと共に導入するガス導入手段とを具え、前記反応管内壁の、ほぼ1000°C以上の高温に加熱される部分の表面に $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0$)膜をコーティングし、有機金属ガスとアンモニアガスとの反応により生成される金属窒化物を、サセプタを介して加熱された基板に堆積させて $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させることを特徴とするIIIV族窒化物膜の製造装置。

【請求項8】前記基板を支持するサセプタの表面を、 $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$, $c>0$)膜をコーティングしたことを特徴とする請求項7に記載のIIIV族窒化物膜の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、基板の上に、有機金属ガスの気相エピタキシャル(Metal Organic Chemical Vapor Deposition:MOCVD)法によってIIIV族窒化物膜、特に $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させる方法およびこのような方法を実施するための装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】発光ダイオード、レーザダイオード、フォトダイオードなどのオプトエレクトロニクスデバイスにおいては、例えばサファイア基板より成る基板上にIIIV族窒化物膜、特に $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させることが提案されている。この $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜のエピタキシャル成長プロセスとしては、従来よりMOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)法やMOVPE(Metalorganic Vapor Phase Epitaxy)法が知られており、最近では塩化物気相エピタキシャル(Hydride Vapor Phase Epitaxy: HVPE)法も提案されている。

【0003】HVPE法でGaN膜を成膜する場合には、表面にGaN薄膜を形成したサファイア基板を内部に保持した反応管内にガリウム金属を装填し、反応管に塩酸ガ

スを導入して塩化ガリウムガスを生成させ、これにアンモニアガスを反応させて窒化ガリウムを堆積させるようにしている。このHVPE法は、MOCVDやMOVPE法に比べて成膜速度が高いという特長がある。例えば、MOVPE法によってGaN膜をエピタキシャル成長させる際の典型的な成膜速度は毎時数 $\mu\text{ m}$ であるが、HVPE法でGaN膜をエピタキシャル成長させる場合の典型的な成膜速度は毎時数百 $\mu\text{ m}$ である。したがって、HVPE法は、特に膜厚の大きなIII-V族窒化物膜を形成する場合に有利に利用できるものである。

【0004】しかしながら、HVPE法では、良好な特性を有する $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜が得られにくいと共に基板内での膜厚の変動が比較的大きくなるという問題がある。一方、MOVPE法では、成膜速度が遅く、コストが高くなるという問題がある。

【0005】また、MOCVD法で $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜を成膜する場合には、加熱装置によって所定の温度に加熱されたサセプタ上に載置された基板を反応管内に保持し、この反応管に、トリメチルアルミニウムガス、トリメチルガリウムガスまたはトリメチルインジウムガスまたはこれらの有機金属ガスの2種以上の混合ガスと、アンモニアとを、水素や窒素のようなキャリアガスと一緒に導入し、有機金属とアンモニアとの反応によって $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)で表わされる膜、すなわちアルミニウム窒化膜、ガリウム窒化膜、インジウム窒化膜あるいはアルミニウム-ガリウム窒化膜、アルミニウム-インジウム窒化膜、ガリウム-インジウム窒化膜を基板上に堆積させるようにしている。

【0006】

【発明が解決すべき課題】上述したようにMOCVD法によって $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜を成膜する従来の方法において、反応管内で有機金属ガスの気相反応が起こると、成膜効率が低下し、成膜速度が非常に低くなってしまうので、反応管内に導入される原料ガスを冷却したり、反応管内壁の一部分を冷却することが提案されている。一方、MOCVD法によって $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜を成膜する際に、反応管内壁の高温になる部分をアンモニアガスによる腐食から保護するための保護層をコーティングすることも提案されている。このコーティング材料としては、SiC, p-BN, TaCx, NbNxなどが用いられている。

【0007】しかしながら、このような材料を反応管内壁の高温部分にコーティングすると、この高温部分の表面には、生成した $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)が付着せず、パーティクルが発生する。特に高温となる部分では、内壁の持つ触媒効果と組合わざり気相反応が促進されるので、高温部分近傍で $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)が生成し、多量のパーティクルが発生することになる。特に、AIN膜やアルミリッチな $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$ 、 $x>0.5$)膜を成膜する場合に使用されるトリメチルアルミニウムガスは気相反応が激しく、パーティクルが顕著に発生されることになる。

【0008】このように、反応管内の高温に加熱される部分に、アンモニアガスによる腐食を防止する保護膜をコーティングすると、その部分に多量の生成物が発生し、これらの生成物は反応管内壁に付着できないので、原料ガスやキャリアガスの流れに飛ばされてパーティクルとして基板上に到達し、ここに堆積されることになる。このように基板上にパーティクルが堆積されると、基板上に本来形成すべき $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜、特にAIN膜やアルミリッチな $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$ 、 $x>0$)膜の特性が著しく劣化してしまうことを確かめた。

【0009】上述したIIIV族窒化物膜の製造装置において、反応管内の100°C以上の高温に加熱される部分は、典型的には基板を支持するサセプタ表面であるが、この部分は基板に隣接しているので、この部分に堆積されたパーティクルは基板表面へ容易に移動し、基板上に成膜される $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜の特性を劣化させることになる。

【0010】図1Aは、従来の製造装置において、新品のサセプタを用いて3インチのウエファより成る基板上にAIN膜を成膜した場合の膜特性を示すものであり、斜線を付けて示したウエファの周辺部分のAIN膜の特性が劣化していることを表している。特に新品のサセプタを使用する場合には、その表面にアルミ窒化物のパーティクルが堆積し易く、特性が劣化し易い。

【0011】さらに、製造コストを下げるために、基板として直径の大きなウエファ、例えば3インチウエファが使用されるようになって来たが、このように大きなウエファを使用する場合には、パーティクルによって特性が劣化する周辺部分が一層大きなものとなる。

【0012】本発明の目的は、上述した従来の問題点を解決し、MOCVD法によって特性が良好な $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させることができるIII-V族窒化物膜の製造方法および装置を提供しようとするものである。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明によるIII-V族窒化物膜の製造方法は、有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスと直接接触する内壁の、ほぼ $1000^{\circ}C$ 以上の高温に加熱される部分の表面に $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングした反応管内に原料ガスをキャリアガスと共に導入し、有機金属ガスとアンモニアガスとの反応により生成される金属窒化物を、加熱されたサセプタによって支持された基板に堆積させて $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させて成膜することを特徴とするものである。

【0014】本発明においては、上述した $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜のコーティングには、酸素、シリコン、マグネシウムあるいは内壁母材に含まれる元素等が数%以下含まれる場合も含まれる。また、 $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜の組成は膜厚方向に向かって均一な組成である必要はなく、平均組成を示すものである。組成の異なる層が多層化したもの、あるいは、連続的に組成の変化したものでも良い。

【0015】このような本発明によるIII-V族窒化物膜の製造方法を実施する場合には、前記基板を支持するサセプタの表面に $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングした反応管を使用するのが好適である。MOCVD法によってIII-V族窒化物膜の製造する場合には、通常基板はほぼ $1000^{\circ}C$ の温度に加熱されるので、基板を支持するサセプタの表面は $1000^{\circ}C$ 以上の高温に加熱されるので、このサセプタの表面に $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングすることができる。このような $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1, a>0$)膜をコーティングすると、この膜の表面には、 $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜が成長され、上述したパーティクルは発生しなくなり、その結果として成膜された $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜の特性は良好なものとなる。

【0016】さらに、本発明によるIIIV族窒化物膜の製造方法の好適な実施例においては、前記反応管内に、多量のトリメチルアルミニウムガスとアンモニアガスとを含む原料ガスを導入してアルミリッチな $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$ 、 $x>0.5$)膜を成膜するか、または前記反応管内に、トリメチルアルミニウムガスとアンモニアガスとを含む原料ガスを導入してAIN膜を成膜する。

【0017】また、本発明によるIIIV族窒化物膜の製造方法において、 $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜を成長させる基板は、 Al_2O_3 、SiC、 NdGaO_3 、 LiGaO_3 、各種組成の AlGaInN 、 ZnO 、 MgO または MgAl_2O_4 の単結晶基板とするか、上記基板本体の表面に ZnO あるいは各種組成の AlGaInN 膜をエピタキシャル成長させた基板と/orができる。後者の膜をエピタキシャル成長させた基板を用いる場合には、それぞれの膜は各種の薄膜成膜方法によって成膜することができる。

【0018】さらに、本発明は、MOCVD法によって基板上に $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させる装置において、反応管と、この反応管の内部に曝されるように基板を支持するサセプタと、このサセプタを介して前記基板を加熱する加熱手段と、前記反応管内に有機金属ガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスをキャリアガスと共に導入するガス導入手段とを具え、前記反応管内の、ほぼ 1000°C 以上の高温に加熱される部分の表面に $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0$)膜をコーティングし、有機金属ガスとアンモニアガスとの反応により生成される金属窒化物を、サセプタを介して加熱された基板に堆積させて $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させるように構成したことを特徴とするものである。

【0019】本発明によるIIIV族窒化物膜の製造装置の好適な実施例においては、前記基板を支持するサセプタの表面に、 $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0$)膜をコーティングする。また、このようなIIIV族窒化物膜の製造装置においては、前記サセプタの表面にAIN膜またはアルミリッチな $\text{Al}_a\text{Ga}_b\text{In}_c\text{N}$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0.5$)膜をコーティングするのが好適である。

【0020】

【発明の実施の形態】図2は、サファイア基板の上にAIN膜を成膜する本発明によるIIIV族窒化物膜の製造方法を実施する製造装置の一実施例の構成を示す線

図的な断面図である。本例においては、石英より成る反応管11の中央下部には、サファイア基板12を水平に保持するサセプタ13と、このサセプタを介してサファイア基板を所定の温度に加熱する加熱装置14とを配置する。このようにして、本例では、サファイア基板12を水平方向上向きに保持しているが、水平方向下向きに保持しても良い。

【0021】反応管11の右端には、反応管内に原料ガスをキャリアガスを導入するためのガス導入管を設ける。すなわち、トリメチルアルミニウムガスを水素ガスと共に導入する第1の導入管15と、アンモニアガスを導入する第2の導入管16と、水素および窒素を含むキャリアガスを導入する第3の導入管17とを設ける。第1および第2の導入管15および16によって導入されたトリメチルアルミニウムガスと、アンモニアガスとはそれぞれ別個のガイド管18および19によって反応管11の内部まで案内され、サファイア基板11から離れた場所でこれらのガスが反応しないようにしている。反応管11の左端には排気ダクト20が設けられ、これを経て排気系へ連通されている。

【0022】サファイア基板12は、加熱装置14によってほぼ1000°Cの温度に加熱されるので、サセプタ13の表面の温度はほぼ1000°C以上の高温となっている。したがってこのサセプタの表面にはパーティクルが堆積し易くなり、このパーティクルは原料ガスおよびキャリアガスの流れによって流されてサファイア基板11上に堆積されて膜特性を劣化することになる。本実施例では、このような問題を解決するために、図3に示すようにサファイア基板11を支持するサセプタ13の表面および側面にAlN膜21をほぼ1μmの膜厚で形成する。このようなAlN膜21を形成しておくと、その表面にはAlNがコーティング膜に付着され易くなり、AlN膜21の膜厚が厚くなるが、パーティクルは発生しなくなる。したがって、サファイア基板12上に形成されるAlN膜はパーティクルの影響を受けず、良好な特性を有するものとなると共に図1Bに示すように、サファイア基板12の周辺部まで良好な特性を有するAlN膜が成膜され、それだけ製造コストを下げることができる。

【0023】本発明は上述した実施例にのみ限定されるものではなく、幾多の変更や変形が可能である。例えば、上述した実施例では、基板を支持するサセプタ

13の表面にAlN膜21をコーティングしたが、反応管内の他の高温に加熱される部分にコーティングすることもできる。さらに、AlN膜21の代わりにアルミリッチな $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0.5$)膜をコーティングしたり、 $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$)膜をコーティングすることもできる。また基板は、サファイア(Al_2O_3)に限定されるものではなく、SiC、各種組成の $AlGaInN$, $NdGaO_3$, $LiGaO_3$, ZnO , MgO または $MgAl_2O_4$ の単結晶基板とするか、上記基板本体の表面に ZnO 膜あるいは各種組成の $AlGaInN$ をエピタキシャル成長させた基板とすることができる。上記基板本体の表面のそれぞれの膜は各種の薄膜成膜方法により成膜することができる。

【0024】また、サセプタの形状については幾多の変更が可能である。例えば、上述した実施例ではサセプタの平坦な表面上にウェハ状の基板を載置したが、図4に示すようにサセプタ13の表面にざぐり13aを形成し、このざぐり内に基板12を設置しても良い。この場合、基板上でのガスの流れを乱さないように、基板表面とAlN膜コーティング21の表面とを同一面とするのが好適である。また、原料ガスが直接接しない基板とサセプタの接触部あるいはサセプタの側面には、コーティングを施さないことも可能である。

【0025】上述したように、本発明によるIIIV族窒化物膜の製造方法および製造装置によれば、反応管内のほぼ $1000^{\circ}C$ の高温に加熱される部分に $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$)膜、特にAlN膜あるいはアルミリッチな $Al_aGa_bIn_cN$ (ただし $a+b+c=1$, $a>0.5$)膜をコーティングしたので、この部分に金属窒化物が成膜され易くなり、したがってそのパーティクルが堆積されることがなくなる。その結果として、基板上に成膜される $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$)膜、特にAlN膜あるいはアルミリッチな $Al_xGa_yIn_zN$ (ただし $x+y+z=1$, $x>0.5$)膜の特性がパーティクルによって劣化することがなくなり、特性の優れた膜を得ることができる。勿論、コーティング膜はアンモニアガスによる腐食から反応管やサセプタを保護する作用も有しているので、製造装置の耐久性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】AおよびBは、それぞれ従来の製造方法および本発明の製造方法によって3インチウエファ基板上に成膜したAlN膜の特性を示す平面図である。

【図2】本発明によるIIIV族窒化物膜の製造装置の一実施例の構成を線図的に示す断面図である。

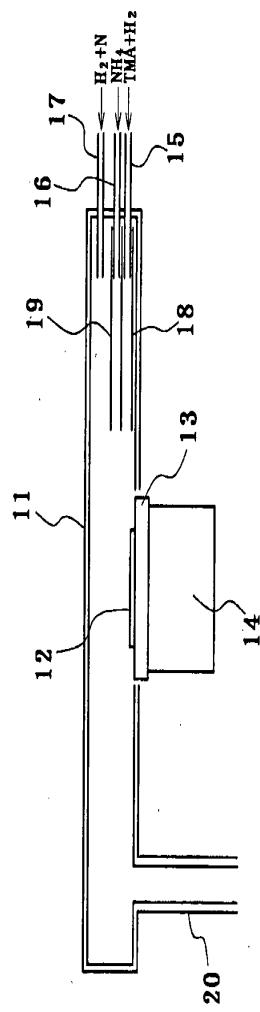
【図3】同じくそのサセプタ部分を拡大して示す断面図である。

【図4】本発明によるIIIV族窒化物膜の製造装置の他の実施例のサセプタ部分を拡大して示す断面図である。

【符号の説明】

- 11 反応管、 12 基板、 13 サセプタ、 14 加熱装置
15、16、17 ガス導入管、 18、19 ガイド管、 20 排気ダクト
21 AlN膜コーティング

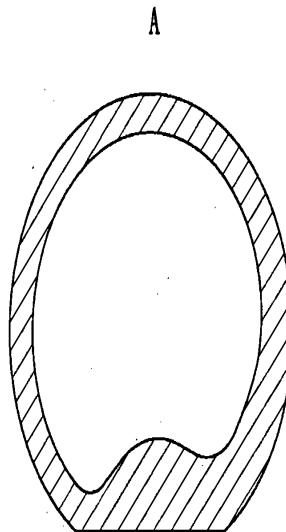
【図2】



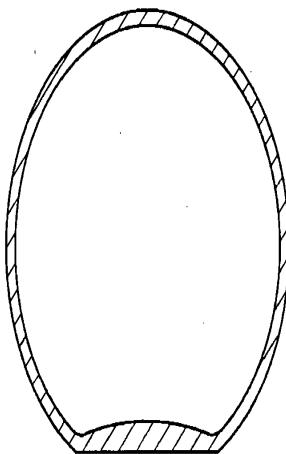
【書類名】

図面

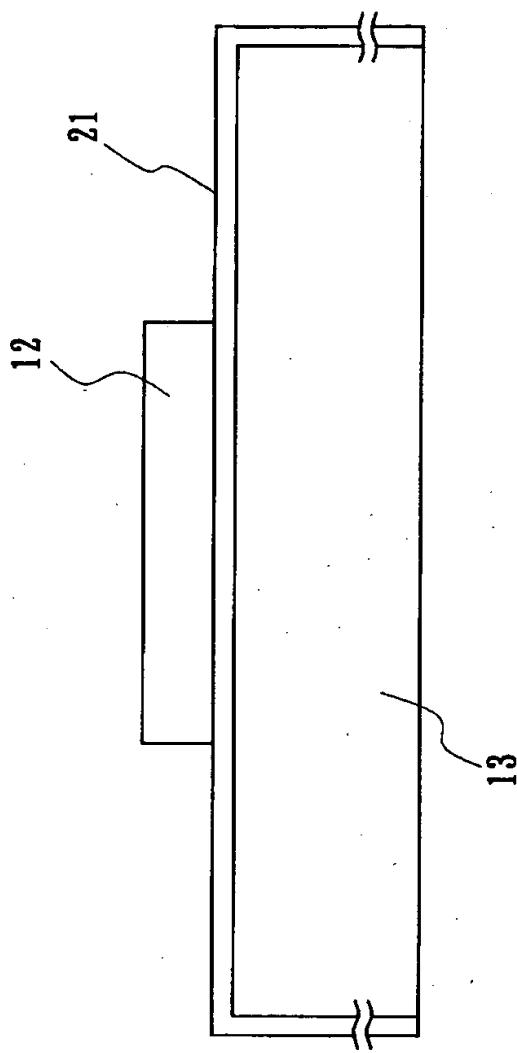
【図1】



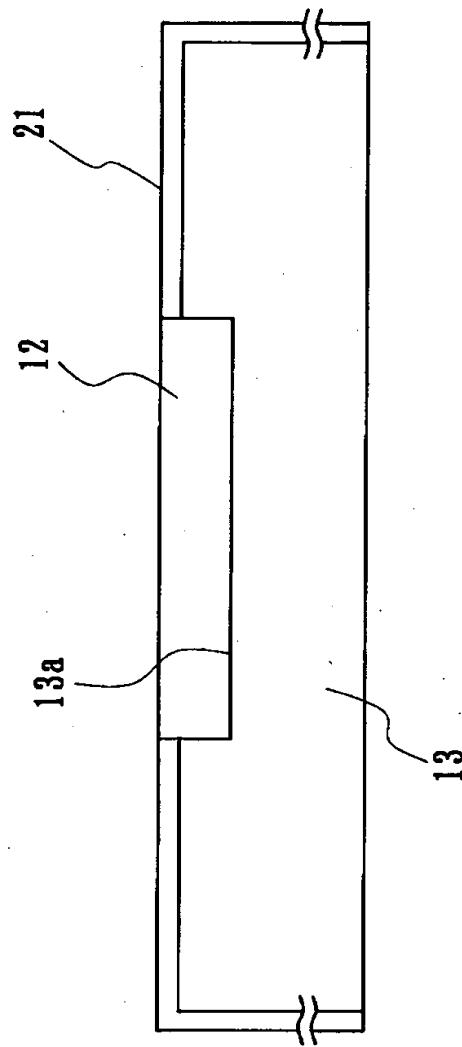
B



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 MOCVD法によって特性が良好な $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{N}$ (ただし $x+y+z=1$)膜をエピタキシャル成長させるIII-V族窒化物膜の製造方法および装置を提供する。

【解決手段】 反応管11の中央にサセプタ13を介して加熱される基板12を配置し、反応管の一端からトリメチルアルミニウムガスおよびアンモニアガスを含む原料ガスおよびキャリアガスを導入し、トリメチルアルミニウムガスおよびアンモニアガスの反応によって生成されるAIN膜を基板の表面に成膜する。基板12を支持するサセプタ13の表面は1000°Cの高温に加熱されるが、この表面にAIN膜21をコーティングしておき、ここにAINのパーティクルが堆積されないようにして、パーティクルが基板上のAIN膜に移ることによる特性の劣化を防止する。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号 [000004064]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
氏 名 日本碍子株式会社



Creation date: 01-16-2004

Indexing Officer: LNGUYEN18 - LAM NGUYEN

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 10004345

Legal Date: 08-09-2002

No.	Doccode	Number of pages
1	CTRS	4

Total number of pages: 4

Remarks:

Order of re-scan issued on